

審決

不服 2015- 2958

大阪府大阪市中央区城見 2 丁目 1 番 6 1 号
請求人 パナソニック IP マネジメント株式会社

大阪府大阪市中央区城見 2 丁目 1 番 6 1 号 パナソニック IP マネジメント株式会社内
代理人弁理士 藤井 兼太郎

大阪府大阪市中央区城見 2 丁目 1 番 6 1 号 パナソニック IP マネジメント株式会社内
代理人弁理士 鎌田 健司

大阪府大阪市中央区城見 2 丁目 1 番 6 1 号 パナソニック IP マネジメント株式会社内
代理人弁理士 前田 浩夫

特願 2012-531914 「太陽電池セルの製造方法および太陽電池モジュールの製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成 24 年 3 月 8 日国際公開、WO 2012/029847、請求項の数（5）〕について、次のとおり審決する。

結 論
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。

理 由

第 1 手続きの経緯

本願は、平成 23 年 8 月 31 日（優先権主張 平成 22 年 8 月 31 日）を国際出願日とする出願であって、平成 26 年 6 月 9 日付けで拒絶理由が通知され、同年 7 月 29 日付けで意見書が提出されるとともに同日付けで手続補正がなされたが、同年 11 月 27 日付けで拒絶査定がなされ、これに対して平成 27 年 2 月 17 日に該拒絶査定を不服として審判請求がなされるとともに、同時に手続補正がなされたものである。

その後、当審において、平成 28 年 1 月 19 日付けで拒絶理由が通知され、平成 28 年 2 月 19 日付けで意見書が提出されるとともに同日付けで手続補正がなされたものである。

第 2 本願発明

本願発明は、平成 28 年 2 月 19 日付けの手続補正で補正された特許請求の範囲の請求項 1～5 により特定される次のとおりのものである（以下、これらの請求項に係る発明を項番号に対応して「本願発明 1」などという。）。

「 【請求項 1】

4 つの角部が面取り状である矩形状の光電変換部と、
前記光電変換部の一主面の上に配された電極と、
を有し、
前記一主面は、
半導体基板の面上に形成された開口部を有する絶縁層と前記開口部に形成された電極とを有する太陽電池セルの製造方法であって、
前記半導体基板の面上にテクスチャー構造を形成する工程と、

前記テクスチャー構造上にあり、所定の粘度であって光または熱で硬化する樹脂を用いて樹脂層を形成する工程と、
前記樹脂層を用いて前記開口部と前記テクスチャー構造の凹凸を覆い凹部と凸部とを有する前記絶縁層とを形成する工程と、
メッキ法により前記開口部に前記電極を形成する工程と、を含み、
前記絶縁層を形成する工程は、前記絶縁層の前記凸部の最上点の高さと前記凹部の最下点の高さとの差が前記テクスチャー構造の凸部の最上点の高さと凹部の最下点の高さとの差よりも小さくする工程を含む、
太陽電池セルの製造方法。

【請求項 2】

前記樹脂層を形成する工程は、前記面上に前記樹脂を塗布する工程を含む請求項 1 記載の太陽電池セルの製造方法。

【請求項 3】

前記樹脂は光硬化性樹脂であり、前記絶縁層を形成する工程は前記樹脂層の所定部分に光を選択的に照射して、前記樹脂を硬化させる工程を含む請求項 1～2 記載のいずれか 1 項記載の太陽電池セルの製造方法。

【請求項 4】

前記絶縁層を形成する工程は、前記樹脂層を有機溶剤により部分的に除去する工程を含む請求項 1～3 記載のいずれか 1 項記載の太陽電池セルの製造方法。

【請求項 5】

請求項 1～4 のいずれか 1 項に記載の太陽電池セルの製造方法の工程を含む太陽電池モジュールの製造方法。」

第 3 原査定の拒絶理由についての当審の判断

1 原査定

(1) 原査定の拒絶理由通知の概要

原査定の拒絶理由通知の概要は以下のとおりである。

「この出願の請求項 1～7 に係る発明は、その出願前日本国内又は外国において、頒布された下記 1～7 の刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第 29 条第 2 項の規定により特許を受けることができない。

記

1. 特開昭 60-10790 号公報
2. 特開 2000-58885 号公報
3. 特開 2001-267597 号公報
4. 特開平 7-86554 号公報
5. 特開平 2-231783 号公報
6. 特開 2004-153214 号公報
7. 特開 2004-200328 号公報

[備考]

・請求項 1～4, 7

感光性樹脂を用いてパターンニング工程を容易とすることは慣用手段（例えば、引用文献 5～7 参照）であるから、例えば、引用文献 1～2 に記載されるごとき太陽電池セルの製造方法に当該慣用手段を適用することは、当業者であれば容易に想起し得る事項である。

なお、絶縁層として樹脂を用いることも周知な知見（例えば、引用文献 3～4 参照）にすぎない。

・請求項 5～6

テクスチャー構造は当業者が所望により構成し得る構造と認められる。」

(2) 原査定の概要

「この出願については、平成26年 6月 9日付け拒絶理由通知書に記載した理由によって、拒絶をすべきものです。

なお、意見書及び手続補正書の内容を検討しましたが、拒絶理由を覆すに足る根拠が見いだせません。

〔備考〕

拒絶理由通知に記載のとおりであって、以下に補足する。

・請求項1－5

「樹脂層の凸部の最上点の高さと凹部の最下点の高さとの差が前記テクスチャー構造の凸部の最上点の高さよりも小さくする」との構成は、絶縁層の材料として「樹脂」を選択することにより、必然的に得られる構成と認められる。

よって、「樹脂層を用いて絶縁層を形成する工程」は「前記樹脂層の凸部の最上点の高さと凹部の最下点の高さとの差が前記テクスチャー構造の凸部の最上点の高さよりも小さくする工程」を含むものである。

意見書にてその効果を主張しているところ、発明の詳細な説明

(【0046】－【0047】)を参酌するに、凸部における絶縁層の「厚み」がより重要であると読むのが妥当であると共に、感光性の樹脂を適用するとの構成により必然的に得られている効果と認められる。そして、その効果の程度は不明であり、検証もなされていない。

よって、意見書の主張は採用できない。

なお、補正された請求項1に係る発明は、開口部を有する絶縁層をテクスチャー構造上には形成しない構成も含むものと認められるので、その意味えば、意見書の主張は、請求項1に係る発明に対応する効果の主張とも認められない。」

2 本願発明1について

(1) 引用文献、引用文献の記載事項及び引用発明

ア 原査定の拒絶の理由に引用された、特開昭60－10790号公報(以下「引用文献1」という。)には、以下の事項が記載されている(下線は当審が付与した。)

(ア) 「3. 発明の詳細な説明

〔技術分野〕

本発明は npp^{+} 型、又は nP 型の太陽電池の電極を無電解ニッケルメッキにより形成する方法に関する。

〔背景技術〕

無電解ニッケルメッキによる太陽電池電極形成において、ニッケルメッキのつき方が n 層上と P 層上では異なり(P 層上はつきにくい)、 npp^{+} 型の太陽電池においてはその電極形成条件の制御が非常に困難である。第1図乃至第5図に電極形成の従来方法を示す。

図面において、(6)は P 型基板、(2)は P 型基板(6)の表面に形成された n^{+} 層、(3)は P 型基板(6)の裏面に形成された P^{+} 層、

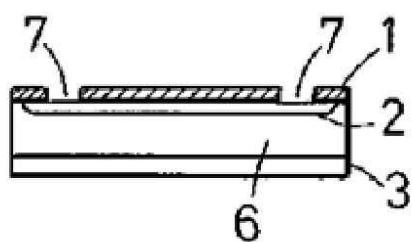
(1)は n^{+} 層(2)上の反射防止膜である。(4)は反射防止膜(1)の窓(7)を介して P 型基板(2)上に設けられたニッケル電極である。

(8)は P^{+} 層の裏面に設けられたニッケル電極である。尚、(4)'、(8)'はニッケル電極(4)、(8)上に二次メッキで形成されたニッケル電極である。(9)はニッケル電極(4)(審決注:「(4)」は「(4)'、(9) 」の誤記と認める。)上にもられた半田である。第1次工程である一次メッキにおいて形成される n 層(2)上のメッキ層(4)の厚さが特性に大きく影響を与え、厚すぎると第3図に示す第2工程であるシンタリング工程で p n 接合の破壊を起こし、薄すぎると第3工程の二次メッキにおいてメッキ層(4)にはがれが発生する。そこで適当な厚さ(最大 0.25μ 程度)のメッキ層の形成が必要であるが、 n 側を P 側でのメッキのつき方が異なるため、 n 側に適当量ついたとしても P 側では二次メッキの第3工程においてメッキ層の剥れが発生する。」(第1頁左下欄第10行～第2頁左上欄第2行)

(イ) 第1図

「

第 1 図

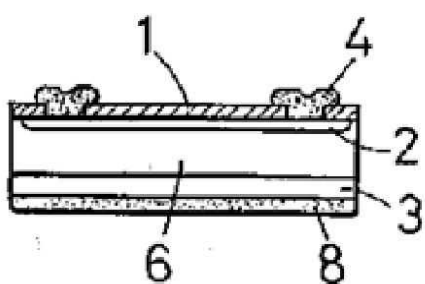


」

(ウ) 第2図

「

第 2 図

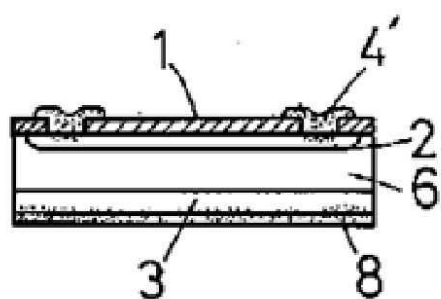


」

(エ) 第3図

「

第 3 図

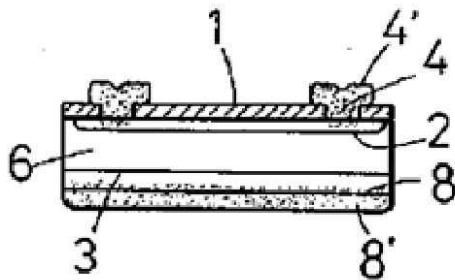


」

(オ) 第4図

「

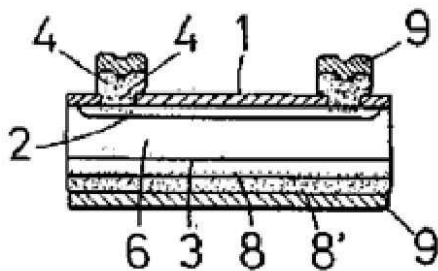
第 4 図



(カ) 第 5 図

「

第 5 図



」

上記（ア）ないし（カ）より、引用文献 1 には、

「P 型基板（6）と、前記 P 型基板の表面に形成された n^+ 層（2）と、前記 P 型基板（6）の裏面に形成された p^+ 層（3）と、前記 n^+ 層（2）上の反射防止膜（1）とを有する太陽電池の電極形成方法であって、前記反射防止膜（1）の窓（7）を介して前記 P 型基板（2）上に設けられたニッケル電極（4）を、一次メッキにおいて形成する第 1 次工程を、含み、

前記ニッケル電極（4）、（8）上に二次メッキで形成されたニッケル電極（4）'、（8）' と、前記ニッケル電極（4）'、（8）' 上にもられた半田（9）を含む、太陽電池の電極形成方法。」

の発明（以下「引用発明」という。）が記載されているものと認められる。

なお、引用文献 1 の本発明において、酸化膜（10）を形成し、それをマスクとして n^+ 層（2）上にニッケルメッキ等によりメッキを行う工程は、背景技術と同様であるので、上記のとおり、背景技術を引用発明と認定した。

イ 原査定の拒絶の理由に引用された、特開 2000-58885 号公報（以下「引用文献 2」という。）には、引用文献 2 には、以下の事項が記載されている（下線は当審が付与した。）。

（ア）「【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は特性の良好な太陽電池及びその製造方法に係わり、特に表面側集電極の構造及び製造方法に関する技術である。」

（イ）「【0028】無電界メッキにより形成される金属材料としては上述した $Ni-P$ の他に $Ni-B$ 或いは Cu があるが、密着性や膜応力の観点から $Ni-P$ が優れている。また、電界メッキによれば Ni の他に

Cu, Cr, Zn, Sn, Agなどを形成することができる。
(実施例) 本発明の実施例として、以下の工程により図1に示す構造の太陽電池を製造した。

【0029】まず、表面がSiO₂で絶縁コートされたステンレス基板1の上に、スパッタ法を用いて厚さ約1μmのAgからなる裏面電極2を形成し、裏面電極2上にプラズマCVD法を用いて厚さ約200Åのn型a-Si層、厚さ約3000Åのi型a-Si層及び厚さ約100Åのp型a-SiC層を順次積層し、アモルファス半導体層3を形成した。

【0030】次いで、アモルファス半導体層3上にスパッタ法を用いてITOからなる厚さ約700Åの透明導電層4を形成し、この透明導電層4上に液体状の酸化珪素剤をスクリーン印刷法により塗布し、200℃程度の温度で30～90分間焼成、硬化させ、集電極を形成する部分に対応する透明導電層4の表面を露出させた状態で透光性絶縁層5（審決注：「5」は「6」の誤記と認める。）を形成した。

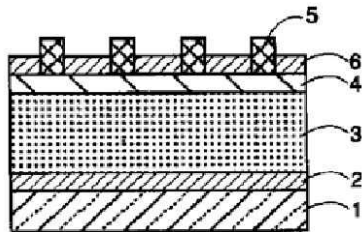
【0031】さらに、透光性絶縁層5（審決注：「5」は「6」の誤記と認める。）表面を脱脂洗浄し、クエン酸アンモニウムで処理した後に、塩化パラジウムと塩化第1錫を主成分とする触媒液に浸漬し、酸性液を使用した活性化処理の後、次亜リン酸ソーダを含む温度40℃程度の硫酸ニッケル中に7分間浸漬することで、透光性絶縁層5から露出した透明導電層4の表面に、Ni-P金属からなる厚さ200nm程度の第一集電極を形成した。

【0032】そして、引き続き硫酸ニッケル、塩化ニッケル及びほう酸の混合溶液を使用してメッキ浴中で電界メッキを行い、15分で厚さ10μm程度のNiからなる第二集電極を形成した。」

(ウ) 図1

「

【図1】



1: 基板 2: 裏面電極 3: アモルファス半導体層
4: 透明導電層 5: 集電極 6: 透光性絶縁層

」

ウ 原査定の拒絶の理由に引用された、特開2001-267597号公報（以下「引用文献3」という。）には、以下の事項が記載されている（下線は当審が付与した。）。

「【0044】実施例4

図3で示すように、樹脂基板18を入射光サイドの封止材として用い、基板18上に透明の電極層19、半導体層及び電極層からなる光電変換層20を積層し、光電変換層20の表面全体を、ポリアリールエーテルケトンからなる樹脂層21で覆った光電変換素子を製造した。

【0045】さらに、図4に示すように、基板22と光電変換層23の全体をポリアリールエーテルケトンからなる樹脂層24で覆い、第2の基板25上に積層して光電変換素子を製造した。この樹脂層24によれば、反射防止層の機能を得ながら、第2の基板25への接着機能をも奏する。また、このような光電変換素子では、基板22の下に金属性（例えば亜鉛塗布鋼板）の基体部材を設けることにより、素子の機械的強度等を高めることができる。また、第1の樹脂基板上に第2の樹脂基板、光散乱層、光電変換層、反射防止層をこの順に積層する光電変換素子を製造することもできる。このときの塗布方式としては、ディップ方式、エヤーガン方式などの極めて低コストの工程が適用できる。」

エ 原査定の拒絶の理由に引用された、特開平 7-86554 号公報（以下「引用文献 4」という。）には、以下の事項が記載されている（下線は当審が付与した。）。

「また端面 16 の一部もしくは全部を一層もしくは二層以上の SiO_2 、 Al_2O_3 等の絶縁膜、又は樹脂等による保護膜、反射膜、無反射膜等を設けてもよく、発光出力を検出する場合に僅かな光が発光出力検出部に達すればよい。また電極 11 と 12、22 の電气的分離をより完全に行なうために、発光部 9 と温度検出部 10、20 の間に位置するの電流狭窄層 6、コンタクト層 5、クラッド層 4 の一部もしくは全部を除去してもよい。」

オ 原査定の拒絶の理由に引用された、特開平 2-231783 号公報（以下「引用文献 5」という。）には、以下の事項が記載されている。

「次に第 1 図のこの発明による半導体レーザの製造方法を第 2 図（a）～（h）について説明する。

まず、分離メサ 11 がはいっているウェハ状態のレーザチップに（第 2 図（a））、ポリイミド膜 12 を塗布により形成した後プリベークする（第 2 図（b））。次に露光、現像を行い電極表面を露出させ、次に $200 \sim 250^\circ\text{C}$ でベーキングを行い、ポリイミド膜 12 を安定化させる（第 2 図（c））。以降の工程は従来例と同様であり、レジスト 13 の塗布後のプリベーク工程（第 2 図（d））、露光、現像による電極表面の露出工程（第 2 図（e））、はんだ材 8 の全面蒸着工程（第 2 図（f））、n 側電極 7 上以外のはんだ材の除去、劈開、コーティング、チップ分離工程（第 2 図（g））、さらにヒートシンク 10 への組立工程（第 2 図（h））によりこの発明の半導体レーザが得られる。」（第 3 頁左上欄第 8 行～右上欄第 2 行）

（ア）「【発明が解決しようとする課題】

カ 原査定の拒絶の理由に引用された、特開 2004-153214 号公報（以下「引用文献 6」という。）には、以下の事項が記載されている。

「【0035】

メサ部作製後、感光性ポリイミドを有機溶媒に溶解したポリイミド溶液をメサ上部全面に塗布した後、ベークして厚さ $1\mu\text{m}$ 程度の感光性ポリイミド層 19 を形成する。次に、フォトリソグラフィ技術により、メサ部上の電流注入領域の感光性ポリイミド層 19 を除く。キャップ層 18 と接して Ti/Pt/Au からなる p 側電極 20、および基板 11 の裏面に AuGe/Ni/Au からなる n 側電極 21 を、電極金属を蒸着法によりコーティングした後、熱処理を施すことにより形成する。」

キ 原査定の拒絶の理由に引用された、特開 2004-200328 号公報（以下「引用文献 7」という。）には、以下の事項が記載されている。

「【0029】

ベンゾシクロブテン樹脂膜 11 のパターン形成などの加工には、硬化処理後に、フォトレジストまたはシリコン酸化膜やシリコン窒化膜などの絶縁膜をマスクとし、フッ素を用いたプラズマエッチングを採用することも可能であるが、本発明においては、製作工程の簡便性およびプラズマエッチングに伴う半導体表面への損傷を回避する点から、露光と現像によるパターン形成が可能な感光性を有するベンゾシクロブテン樹脂組成物を塗布液として用いることがより好ましい。

【0030】

次に、ベンゾシクロブテン樹脂膜 11 上に、プラズマ CVD 法やスパッタ法等により絶縁性無機化合物膜 12 を形成する。その後、フォトレジストをマスクとしたウェットエッチングまたはドライエッチングにより、電極部分の絶縁性無機化合物膜 12 を除去して、第 2 の保護膜である絶縁性無機化合物膜 12 を形成する。」

（2）対比・判断

ア 対比

本願発明 1 と引用発明とを対比する。

(ア) 引用発明の「P型基板(6)」、「窓(7)」、「ニッケル電極(4)」、「太陽電池の電極形成方法」及び「一次メッキ」は、本願発明 1 の「半導体基板」、「開口部」、「電極」、「太陽電池セルの製造方法」及び「メッキ法」に、それぞれ相当する。

(イ) 引用発明の「P型基板(6)」と、前記P型基板の表面に形成された n^{+} 層(2)と、前記P型基板(6)の裏面に形成された P^{+} 層(3)は、本願発明 1 の「光電変換部」に相当し、引用発明の「表面」は本願発明 1 の「一主面」に相当する。

(ウ) 引用発明の「反射防止膜(1)」が絶縁層であることは自明のことであるから、引用発明の「反射防止膜(1)の窓(7)」を有することは、本願発明 1 の「開口部を有する絶縁層」「を有する」ことに相当する。

(エ) 引用発明 1 の「P型基板(6)」と、前記P型基板の表面に形成された n^{+} 層(2)と、前記P型基板(6)の裏面に形成された P^{+} 層(3)

と、前記 n^{+} 層(2)上の反射防止膜(1)とを有する太陽電池の電極形成方法であって、前記反射防止膜(1)の窓(7)を介して前記P型基板(2)上に設けられたニッケル電極(4)を、一次メッキにおいて形成する第1次工程と、を有するとは、本願発明 1 の「前記一主面は、半導体基板の面上に形成された開口部を有する絶縁層と前記開口部に形成された電極とを有する太陽電池セルの製造方法であって、」「メッキ法により前記開口部に前記電極を形成する工程と、を有する」と、「前記一主面は、半導体基板の面上に形成された開口部を有する絶縁層と前記開口部に形成された電極とを有する太陽電池セルの製造方法であって、」「メッキ法により前記開口部に前記電極を形成する工程と、を有する」点で一致する。

上記(ア)ないし(エ)より、本願発明 1 と引用発明は、
「光電変換部と、

前記光電変換部の一主面の上に配された電極と、
を有し、

前記一主面は、
半導体基板の面上に形成された開口部を有する絶縁層と前記開口部に形成された電極とを有する太陽電池セルの製造方法であって、
メッキ法により前記開口部に前記電極を形成する工程と、を含む、
太陽電池セルの製造方法。」

の点で一致し、以下の相違点 1 ないし 4 で相違する。

<相違点 1>

「光電変換部」の形状が、本願発明 1 では、4 つの角部が面取り状である矩形形状であるのに対して、引用発明では、その点が明確でない点。

<相違点 2>

本願発明は、「前記半導体基板の面上にテクスチャー構造を形成する工程と、前記テクスチャー構造上にあり、所定の粘度であって光または熱で硬化する樹脂を用いて樹脂層を形成する工程と、前記樹脂層を用いて前記開口部と前記テクスチャー構造の凹凸を覆い凹部と凸部とを有する前記絶縁層とを形成する工程と」を含むのに対して、引用発明は、「P型基板(6)」にテクスチャー構造を形成する工程を含まない点。

<相違点 3>

本願発明は、「前記絶縁層を形成する工程は、前記絶縁層の前記凸部の最上点の高さと前記凹部の最下点の高さとの差が前記テクスチャー構造の凸部の最上点の高さと凹部の最下点の高さとの差よりも小さくする工程」を含むのに対して、引用発明は、そのような工程を含まない点。

イ 判断

事案に鑑み、まず、相違点 2、3 について検討する。

太陽電池の製造方法において、テクスチャー構造を形成することは周知技術であるものの、引用発明の「ニッケル電極（４）を、一次メッキにおいて形成する」ために用いられる「反射防止膜（１）の窓（７）」を形成する前の「Ｐ型基板（６）」、「 n^+ 層（２）」に、テクスチャー構造を形成するという動機付けはない。

仮に、引用発明の「Ｐ型基板（６）」、「 n^+ 層（２）」にテクスチャー構造を形成し、引用発明の「 n^+ 層（２）上」の「反射防止膜（１）」として、樹脂層を用いて絶縁層を形成し、絶縁層の凸部の最上点の高さと前記凹部の最下点の高さとの差が前記テクスチャー構造の凸部の最上点の高さと凹部の最下点の高さとの差よりも小さくするようにする。すなわち、引用発明の「Ｐ型基板（６）」、「 n^+ 層（２）」にテクスチャー構造を採用し、「反射防止膜（１）」として、テクスチャー構造を打ち消すような樹脂層を選択するとする。しかし、そのような樹脂層を選択すれば、テクスチャー構造の凸部での「反射防止膜（１）」の膜厚は、テクスチャー構造の凹部での「反射防止膜（１）」の膜厚よりも小さくなり、テクスチャー構造の凸部での「反射防止膜（１）」の光路長は、テクスチャー構造の凹部での「反射防止膜（１）」の光路長よりも小さくなる。すると、「反射防止膜（１）」は、反射防止膜として十分に機能しなくなる。

してみると、引用発明において、「Ｐ型基板（６）」、「 n^+ 層（２）」にテクスチャー構造を形成し、「反射防止膜（１）」としてテクスチャー構造を打ち消すような樹脂層を選択することに、阻害要因がある。

また、引用文献 2～7 にも、テクスチャー構造を形成することは記載されていない。

したがって、引用発明において上記相違点 2、3 にかかる構成とすることは、当業者といえども、容易に想到し得ることとはいえない。

よって、相違点 1 について検討するまでもなく、本願発明 1 は、引用発明、引用文献 2～7 に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとするとはできない。

3 本願発明 2～5 について

本願発明 2～5 は、本願発明 1 をさらに限定するものであるから、本願発明 1 と同様に、引用発明、引用文献 2～7 に記載された事項に基いて、当業者が容易に発明をすることができたものとするとはできない。

4 まとめ

以上のとおり、本願発明 1～5 は、引用発明、引用文献 2～7 に記載された事項に基いて当業者が容易に発明をすることができたものとするとはできない。

第 4 当審の拒絶理由についての当審の判断

1 当審の拒絶理由通知の概要

「この出願は、特許請求の範囲の記載が下記の点で、特許法第 36 条第 6 項第 2 号に規定する要件を満たしていない。

記

- （１）請求項 1 において、複数の「開口部」の関係が不明確である。
- （２）請求項 1 において、「光や熱に反応性」とはどのような反応性であるのか不明である。
- （３）請求項 1 において、「前記樹脂層に前記開口部を形成する工程」と「前記樹脂層を用いて前記開口部と前記テクスチャー構造の凹凸を覆い凹部と凸部とを有する前記絶縁層とを形成する工程」との関係が不明である。
- （４）請求項 1 を引用する請求項も同様である。

よって、請求項 1 ないし 5 に係る発明は明確でない。」

2 当審の拒絶理由に対する請求人の対応

平成 28 年 2 月 19 日付け手続補正により、特許請求の範囲の請求項 1、2 が以下のとおり補正された。

請求項 1 において、「開口部」は「半導体基板の面上」に形成されること、「テクスチャ構造」は「半導体基板の面上にあ」ること、「樹脂」は「光または熱で硬化」されること、「電極」は「開口部」に形成されることが、補正された。

また、請求項 2 において、「樹脂」は「半導体基板」の「面上」に塗布されることが補正された。

3 当審の判断

上記「2」より、請求項 1～5 に係る発明は明確になったので、当審の拒絶理由は解消された。

第 5 むすび

以上のとおり、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由によっては、本願を拒絶することはできない。

また、他に拒絶すべき理由を発見しない。

よって、結論のとおり審決する。

平成 28 年 4 月 18 日

審判長	特許庁審判官	川端 修
	特許庁審判官	井口 猶二
	特許庁審判官	土屋 知久

〔審決分類〕 P 1 8 . 1 2 1 - W Y (H O 1 L)
5 3 7

審判長	特許庁審判官	川端 修	8718
	特許庁審判官	土屋 知久	8826
	特許庁審判官	井口 猶二	9119